



【800～900万円】SiCエピタキシャル成長プロセス開発エンジニア [53044]

ルネサス エレクトロニクス株式会社での募集です。 プロセスエンジニア（半導体）...

## Job Information

### Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

### Hiring Company

ルネサス エレクトロニクス株式会社

### Job ID

1488137

### Industry

Electronics, Semiconductor

### Job Type

Permanent Full-time

### Location

Ehime Prefecture

### Salary

8 million yen ~ 9 million yen

### Work Hours

08:30 ~ 17:15

### Holidays

【有給休暇】初年度 23日 1か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 夏季休暇 年末年始 【有給休暇】入社月に付与 (...)

### Refreshed

October 24th, 2024 02:00

## General Requirements

### Career Level

Mid Career

### Minimum English Level

Business Level

### Minimum Japanese Level

Native

### Minimum Education Level

Bachelor's Degree

### Visa Status

Permission to work in Japan required

## Job Description

【求人No NJB2133826】

【担当技術】

SiCエピタキシャル成長プロセス開発エンジニア

【担当業務】

SiCエピタキシャル成長装置立ち上げ、プロセス条件出し、量産化

【担当職場】

自社前工程国内拠点

---

## Required Skills

### 【MUST】

SiCエピタキシャル成長プロセス開発の従事経験が2年以上あること。

### 【WANT】

4年制大学または大学院にて工学、化学、物理学等を修了していること。

---

## Company Description

各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス